كتالوج المنتجات

مضخمات قدرة بالحالة الصلبة

مضخمات القدرة بالحالة الصلبة تستخدم عناصر قدرة RF شبه موصلة لتوليد قدرة الإرسال من دون مراحل أنبوبية. تستخدم في مرسلات الاتصالات وقنوات الرادار ومنصات اختبار RF والأنظمة الميكروية المخصصة.



المنتجات: 21

المراجعة: 14 · تاريخ المراجعة: 2026-11-12



LCPAM-2000-6000-100-485

وحدة مضخم قدرة RF عريض النطاق بتقنية GaN، 2–6 GHz، 100 W

LCPAM-2000-6000-100-485 وحدة مضخم RF عالية القدرة وعريضة النطاق بتقنية GaN، تعمل ضمن 2–6 GHz بقدرة خرج مشبع نموذجية 100 W وكسب نموذجي 50 dB. نطاق التغذية 24–32 VDC، مع واجهة RS-485 ومراقبة الحالة والإيقاف الوقائي. يمكن تقييم الوحدة كمرحلة قدرة في أنظمة RF ذات ممانعة 50 Ω.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 2000; الحد الأقصى: 6000; الوحدة: MHz

قدرة خرج RF المشبعة: الرمز: Pout; القيمة النموذجية: 100; الوحدة: W

كسب القدرة: الرمز: Gp; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: dB

جهد التشغيل: الرمز: VDC; الحد الأدنى: 24; القيمة النموذجية: 28; الحد الأقصى: 32; الوحدة: VDC

ما لم يُذكر خلاف ذلك: +28.0 VDC، 25 °C، نظام 50 Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-100-18000-5

مضخم قدرة GaN RF 100–18000 MHz، حد أدنى 5 W

يغطي مضخم GaN نطاق 100–18000 MHz بخرج مشبع أدنى 5 W ونموذجي 7 W. الكسب الأدنى 37 dB والنموذجي 38 dB، واستواء الكسب النموذجي ±0.5 dB.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 100; الحد الأقصى: 18000; الوحدة: MHz

قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; الحد الأدنى: 5; القيمة النموذجية: 7; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 37; القيمة النموذجية: 38; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±0.5; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-10700-12700-100

مضخم قدرة GaN RF 10700–12700 MHz، نموذجي 100 W

يغطي مضخم GaN نطاق 10700–12700 MHz بخرج مشبع نموذجي 100 W وكسب نموذجي 50 dB. الاستواء النموذجي ±1 dB، والتوافقيات النموذجية 50 dBc− عند خرج 100 W.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 10700; الحد الأقصى: 12700; الوحدة: MHz

قدرة خرج RF @ PSAT: الرمز: PSAT; القيمة النموذجية: 100; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±1; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω. تحقّق مع LCRF من تيار التشغيل وسلوك الحماية من فرط التيار قبل تحديد سعة مصدر التغذية.

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-10700-12700-50

مضخم قدرة GaN RF 10700–12700 MHz، نموذجي 50 W

يوفر مضخم GaN خرجًا مشبعًا نموذجيًا 50 W على 10700–12700 MHz وكسبًا نموذجيًا 47 dB. التيار الديناميكي النموذجي 10 A عند 50 W وتيار السكون النموذجي 1.6 A.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 10700; الحد الأقصى: 12700; الوحدة: MHz

قدرة خرج RF @ PSAT: الرمز: PSAT; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; القيمة النموذجية: 47; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±1; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-10700-12750-100

مضخم قدرة GaN RF 10700–12750 MHz، نموذجي 100 W، مع محول WR75

يغطي مضخم GaN نطاق 10700–12750 MHz بخرج مشبع نموذجي 100 W وكسب أدنى 50 dB. قدرة الخرج النموذجية عند انضغاط 1 dB هي 40 W، والتيار النموذجي 21 A عند 100 W.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 10700; الحد الأقصى: 12750; الوحدة: MHz

قدرة الخرج عند انضغاط 1 dB: الرمز: P-1dB; القيمة النموذجية: 40; الوحدة: W

قدرة خرج RF @ PSAT: الرمز: PSAT; القيمة النموذجية: 100; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 50; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-2000-6000-20

مضخم قدرة GaN RF 2000–6000 MHz، خرج مشبع نموذجي 25 W

تحدد ورقة هذا الطراز خرجًا مشبعًا نموذجيًا 25 W على 2000–6000 MHz وكسبًا نموذجيًا 44 dB. التيار النموذجي 2.5 A وفعالية إضافة القدرة 30% كلاهما عند خرج 20 W.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 2000; الحد الأقصى: 6000; الوحدة: MHz

قدرة خرج RF @ PSAT: الرمز: PSAT; القيمة النموذجية: 25; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; القيمة النموذجية: 44; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±1; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-20-520-200A

وحدة مضخم قدرة RF من نوع LDMOS بتردد 20–520 MHz وخرج مشبع 200 W

تستخدم الوحدة مرحلة نهائية LDMOS وتغطي 20–520 MHz بقدرة مشبعة نموذجية 200 W. تحدد القدرة عند انضغاط 1 dB بشكل منفصل عند 50 W نموذجياً، والكسب للإشارة الصغيرة عند 53 dB نموذجياً.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 20; الحد الأقصى: 520; الوحدة: MHz

قدرة خرج RF المشبعة: الرمز: Psat; القيمة النموذجية: 200; الوحدة: W

قدرة الخرج عند انضغاط 1 dB: الرمز: P1dB; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: W

كسب الإشارة الصغيرة: الرمز: G; القيمة النموذجية: 53; الوحدة: dB

25 °C; 50 Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-20-520-350

مضخم قدرة LDMOS RF 20–520 MHz، خرج مشبع نموذجي 350 W

يغطي مضخم LDMOS نطاق 20–520 MHz بخرج مشبع نموذجي 350 W وخرج نموذجي 150 W عند انضغاط 1 dB. الكسب النموذجي 56 dB، والتيار النموذجي 29 A عند 350 W وتغذية نموذجية 48 VDC.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 20; الحد الأقصى: 520; الوحدة: MHz

قدرة الخرج عند انضغاط 1 dB: الرمز: P-1dB; القيمة النموذجية: 150; الوحدة: W

قدرة خرج RF @ PSAT: الرمز: PSAT; القيمة النموذجية: 350; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; القيمة النموذجية: 56; الوحدة: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-3000-8000-100-485

مضخم قدرة GaN RF 3000–8000 MHz، نموذجي 100 W، مع RS-485

يغطي مضخم GaN نطاق 3000–8000 MHz بقدرة خرج مشبعة أدنى 80 W ونموذجية 100 W. الكسب الأدنى 49 dB والنموذجي 50 dB، والتيار النموذجي 18 A عند خرج 100 W.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 3000; الحد الأقصى: 8000; الوحدة: MHz

قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; الحد الأدنى: 80; القيمة النموذجية: 100; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 49; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±2; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-30-1000-10

مضخم قدرة GaN RF 30–1000 MHz، نموذجي 10 W

يغطي مضخم GaN نطاق 30–1000 MHz بخرج مشبع أدنى 9 W ونموذجي 10 W. الكسب النموذجي 40 dB والاستواء ±1 dB؛ التيار النموذجي 0.6 A عند خرج 10 W.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 30; الحد الأقصى: 1000; الوحدة: MHz

قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; الحد الأدنى: 9; القيمة النموذجية: 10; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; القيمة النموذجية: 40; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±1; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-30-1500-1

مضخم قدرة GaN RF 30–1500 MHz، حد أدنى 1 W

تحدد هذه الوحدة خرجًا مشبعًا لا يقل عن 1 W وكسبًا لا يقل عن 30 dB على 30–1500 MHz. التيار النموذجي 0.15 A عند 1 W، واستواء الكسب النموذجي ±1 dB.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 30; الحد الأقصى: 1500; الوحدة: MHz

قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; الحد الأدنى: 1; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 30; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±1; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-30-2000-1

مضخم قدرة GaN RF 30–2000 MHz، حد أدنى 1 W

يغطي هذا الطراز 30–2000 MHz كما في الجدول الكهربائي، بخرج مشبع أدنى 1 W وكسب أدنى 30 dB. التوافقيات النموذجية 12 dBc− عند 1 W، والإشارات الطفيلية النموذجية 60 dBc− عند التشبع.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 30; الحد الأقصى: 2000; الوحدة: MHz

قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; الحد الأدنى: 1; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 30; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: 1±; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-5000-6000-100

وحدة مضخم قدرة RF بتقنية GaN، من 5 إلى 6 GHz، بقدرة 100 W≥

يضمن تصنيف LCPAM-5000-6000-100 حداً أدنى 100 W للخرج المشبع وكسباً أدنى 50 dB عند PSAT في النطاق 5– 6 GHz، وفق شروط 28 VDC و25 °C ونظام 50 Ω.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 5000; الحد الأقصى: 6000; الوحدة: MHz

قدرة خرج RF المشبعة: الرمز: PSAT; الحد الأدنى: 100; الوحدة: W; PSAT

كسب القدرة (PSAT): الرمز: Gp; الحد الأدنى: 50; الوحدة: dB; PSAT

استواء كسب القدرة (PSAT): الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: 1±; الوحدة: dB; PSAT

28 VDC; 25 °C; 50 Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-5000-8500-25

مضخم قدرة GaN RF 5000–8500 MHz، نموذجي 25 W

يغطي مضخم GaN نطاق 5000–8500 MHz بخرج مشبع أدنى 20 W ونموذجي 25 W. الكسب الأدنى 43 dB والنموذجي 44 dB؛ التوافقيات النموذجية 40 dBc− عند خرج 20 W.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 5000; الحد الأقصى: 8500; الوحدة: MHz

قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; الحد الأدنى: 20; القيمة النموذجية: 25; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 43; القيمة النموذجية: 44; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: 0.5±; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-500-2500-100A

مضخم قدرة GaN RF 500–2500 MHz، نموذجي 100 W، إصدار A

يغطي مضخم GaN إصدار A نطاق 500–2500 MHz بخرج مشبع نموذجي 100 W وكسب نموذجي 50 dB. التيار النموذجي 12 A عند 100 W، بينما قياس التوافقيات مرتبط بخرج 70 W.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 500; الحد الأقصى: 2500; الوحدة: MHz

قدرة خرج RF @ PSAT: الرمز: PSAT; القيمة النموذجية: 100; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±2; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω يحدد الجدول الكهربائي 26 VDC كحد أدنى و28 VDC كقيمة نموذجية و30 VDC كحد أقصى، بينما يذكر صف A1 VDD نطاق 28–32 VDC. لا يُنشر ادعاء نطاق تغذية A1. يجب تأكيد النطاق المسموح وتوصيل A1 قبل التغذية؛ ولا تُعد 32 VDC هنا حداً أقصى مقبولاً للتشغيل.

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-6000-18000-50

مضخم قدرة RF صلب الحالة 6–18 GHz، نموذجي 50 W

يغطي مضخم الحالة الصلبة 6–18 GHz بخرج مشبع أدنى 45 W ونموذجي 50 W عند دخل 0 dBm. الكسب النموذجي 47 dB، واستواء الكسب نموذجيًا ±1.5 dB وبحد أقصى ±2.5 dB في شرط الدخل نفسه.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 6; الحد الأقصى: 18; الوحدة: GHz

قدرة خرج RF المشبعة @ Pin = 0 dBm: الرمز: Psat; الحد الأدنى: 45; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: W

كسب القدرة @ Pin = 0 dBm: الرمز: Gp; القيمة النموذجية: 47; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ Pin = 0 dBm: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±1.5; الحد الأقصى: ±2.5; الوحدة: dB

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-6000-8500-20

مضخم قدرة GaN RF 6000–8500 MHz، حد أدنى 20 W

تحدد ورقة هذا الطراز خرجًا مشبعًا أدنى 20 W ونموذجي 25 W على 6000–8500 MHz. التيار النموذجي 2.5 A وفعالية إضافة القدرة 30% عند 20 W؛ تيار السكون النموذجي 1.8 A.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 6000; الحد الأقصى: 8500; الوحدة: MHz

قدرة خرج RF @ PSAT: الرمز: PSAT; الحد الأدنى: 20; القيمة النموذجية: 25; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 43; القيمة النموذجية: 44; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±0.5; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-6000-8500-25

مضخم قدرة GaN RF 6000–8500 MHz، نموذجي 25 W

يسجل هذا الطراز خرجًا مشبعًا نموذجيًا 25 W وأدنى 20 W على 6000–8500 MHz. الكسب النموذجي 44 dB والأدنى 43 dB، واستواء الكسب النموذجي ±0.5 dB.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 6000; الحد الأقصى: 8500; الوحدة: MHz

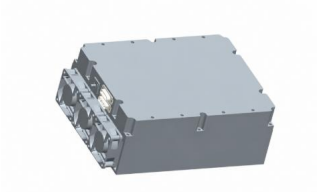
قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; الحد الأدنى: 20; القيمة النموذجية: 25; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 43; القيمة النموذجية: 44; الوحدة: dB

استواء كسب القدرة @ PSAT: الرمز: ΔGp; القيمة النموذجية: ±0.5; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAM-8000-12000-100

مضخم قدرة GaN RF 8000–12000 MHz، نموذجي 100 W

يغطي مضخم GaN نطاق 8000–12000 MHz بخرج مشبع نموذجي 100 W وكسب أدنى 53 dB. الخرج النموذجي عند انضغاط 1 dB هو 20 W، واستواء الكسب النموذجي ±1.5 dB.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 8000; الحد الأقصى: 12000; الوحدة: MHz

قدرة الخرج عند انضغاط 1 dB: الرمز: P-1dB; القيمة النموذجية: 20; الوحدة: W

قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; القيمة النموذجية: 100; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 53; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAS-8000-12000-200

نظام تضخيم قدرة GaN RF 8000–12000 MHz، نموذجي 200 W

يغطي نظام GaN نطاق 8000–12000 MHz بخرج مشبع نموذجي 200 W وخرج نموذجي 40 W عند انضغاط 1 dB. الكسب لا يقل عن 53 dB واستواء الكسب النموذجي ±1.5 dB.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 8000; الحد الأقصى: 12000; الوحدة: MHz

قدرة الخرج عند انضغاط 1 dB: الرمز: P-1dB; القيمة النموذجية: 40; الوحدة: W

قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; القيمة النموذجية: 200; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 53; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCPAS-8000-12000-400

نظام تضخيم قدرة GaN RF 8000–12000 MHz، نموذجي 400 W

يسجل نظام GaN خرجًا مشبعًا نموذجيًا 400 W على 8000–12000 MHz وخرجًا نموذجيًا 120 W عند انضغاط 1 dB. الكسب لا يقل عن 56 dB، واستواء الكسب النموذجي ±1.5 dB.

تردد التشغيل: الرمز: BW; الحد الأدنى: 8000; الحد الأقصى: 12000; الوحدة: MHz

قدرة الخرج عند انضغاط 1 dB: الرمز: P-1dB; القيمة النموذجية: 120; الوحدة: W

قدرة خرج PSAT @ RF: الرمز: PSAT; القيمة النموذجية: 400; الوحدة: W

كسب القدرة @ PSAT: الرمز: Gp; الحد الأدنى: 56; الوحدة: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.